

2016年3月期（2015年4月～2016年3月） 東京エレクトロン 決算説明会

2016年4月26日

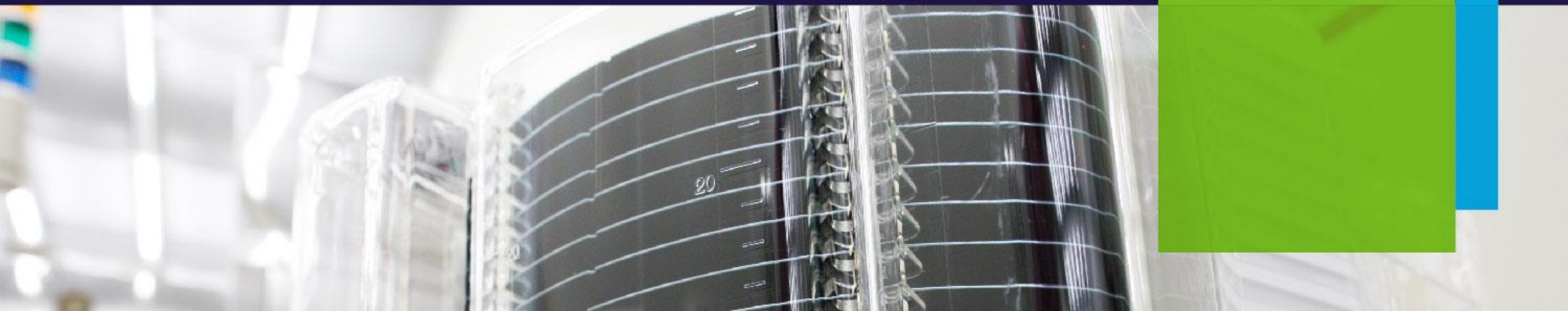
内容：

- 2016年3月期 連結決算の概要 取締役常務執行役員 堀 哲朗
- 事業環境と新生TELを推進するアクション
代表取締役社長、CEO 河合 利樹

2016年3月期 連結決算の概要

2016年4月26日

堀 哲朗
取締役常務執行役員

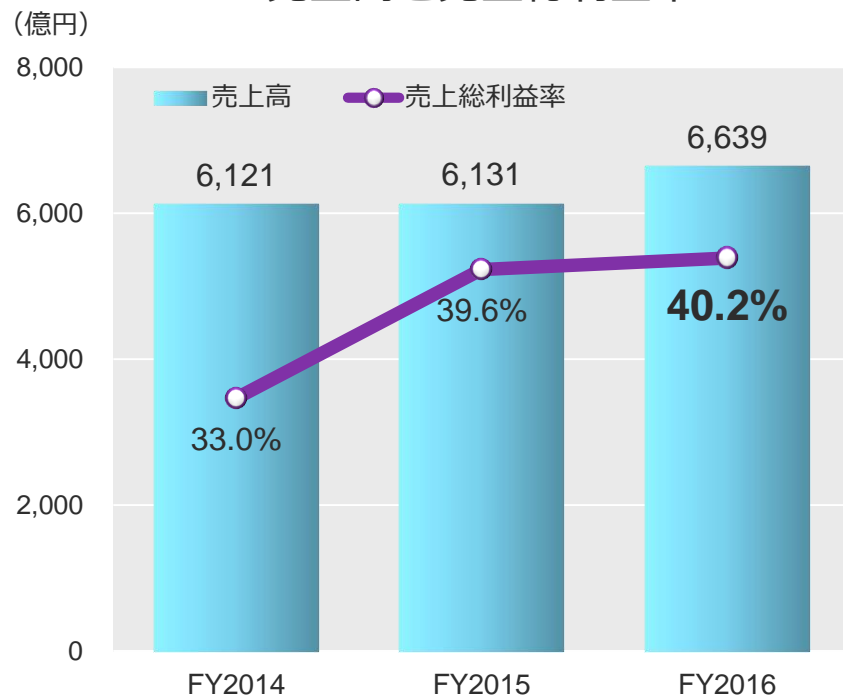


2016年3月期のハイライト

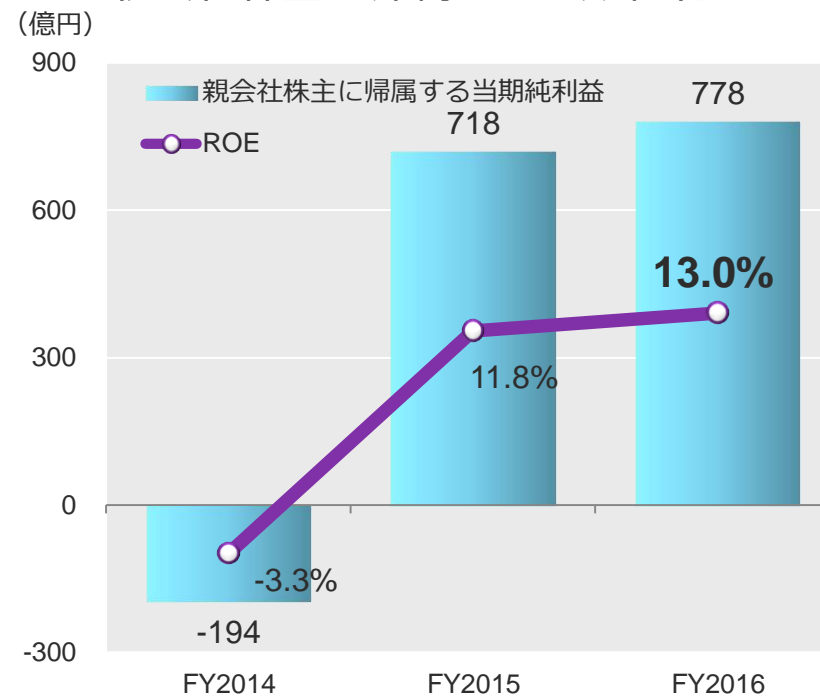
- 半導体製造装置、FPD製造装置ともに増収
- 過去最高の売上総利益率40.2%
- 営業利益率が前期比3.2pts改善の17.6%

2016年3月期 事業ハイライト

売上高と売上総利益率



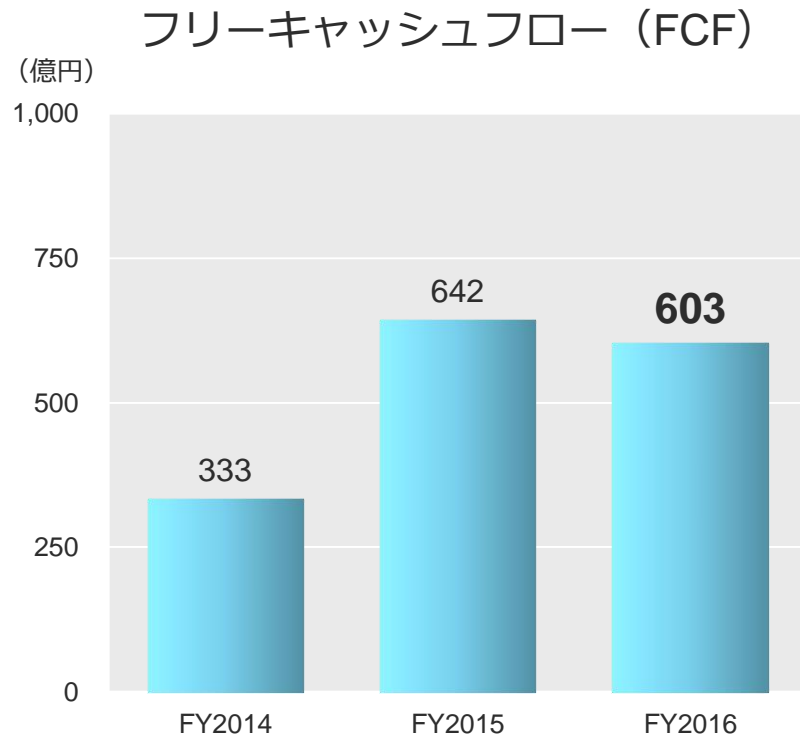
親会社株主に帰属する当期純利益とROE



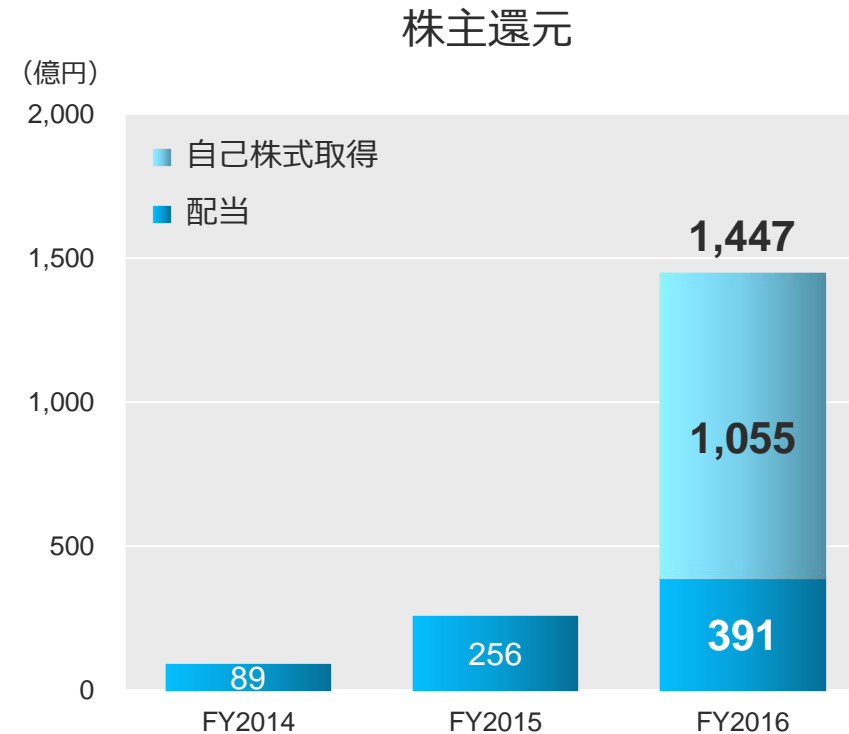
ROE = 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 期首・期末平均自己資本 × 100

**前期比+8.3%の増収、過去最高の売上総利益率を達成
ROEが13%に改善**

2016年3月期 事業ハイライト



フリーキャッシュフロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー (満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く)



FY2016 : 1株当たり中間配当125円、期末配当112円、通期237円の配当を予定

603億円のFCFを創出 1,540万株の自己株式の取得を実施、過去最高の配当を予定

損益状況

(億円)

	2015年3月期	2016年3月期	対前年 増減率	(ご参考) 10/28に発表の 2016年3月期予想
売上高	6,131	6,639	+8.3%	6,600
売上総利益 下段：売上総利益率	2,427 39.6%	2,672 40.2%	+10.1% +0.6pts	
販管費	1,546	1,504	-2.7%	
営業利益 下段：営業利益率	881 14.4%	1,167 17.6%	+32.5% +3.2pts	1,050 15.9%
税前利益	868	1,064	+22.6%	1,000
親会社株主に帰属する 当期純利益	718	778	+8.4%	720
1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益	401.08	461.10	+60.02	
研究開発費	713	762	+6.9%	780
設備投資額	131	133	+1.2%	150
減価償却実施額	208	192	-7.8%	210

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

損益状況

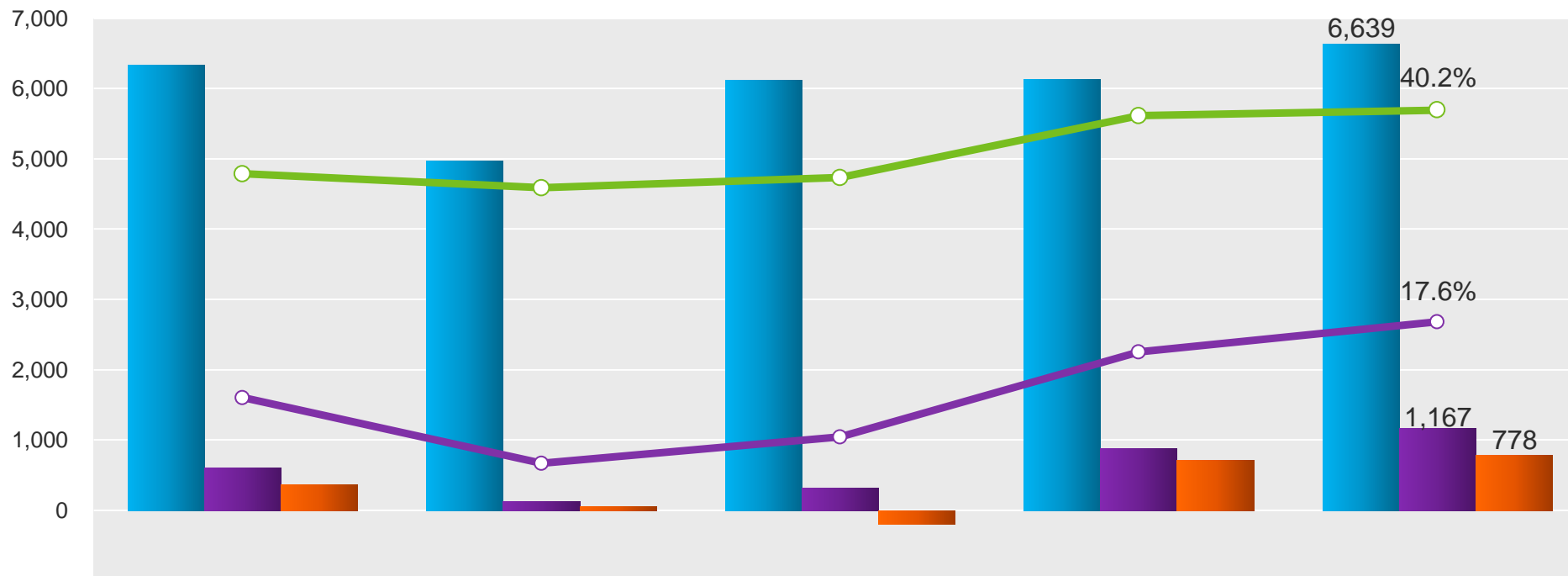
(億円)

	2015年3月期	2016年3月期					対前年4Q 増減率
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
売上高	1,818	1,557	1,851	1,587	1,642	-9.7%	
SPE	1,716	1,403	1,766	1,465	1,495	-12.9%	
FPD	99	100	82	117	146	+47.9%	
PVE	1						
その他	1	53	3	5	0	-	
売上総利益	776	657	703	620	691	-11.0%	
下段：売上総利益率	42.7%	42.2%	38.0%	39.1%	42.1%	-0.6pts	
販管費	417	354	393	365	391	-6.4%	
営業利益	359	302	309	255	300	-16.4%	
下段：営業利益率	19.8%	19.4%	16.7%	16.1%	18.3%	-1.5pts	
税前利益	329	290	284	251	238	-27.8%	
親会社株主に帰属する 当期純利益	344	194	218	178	186	-45.8%	
研究開発費	195	175	200	183	203	+4.1%	
設備投資額	32	21	26	28	56	+74.3%	
減価償却実施額	56	46	47	49	49	-12.5%	

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。
3. PVE（太陽光パネル製造装置事業）については、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」に定める重要性を満たさなくなったため、FY16/1Qより報告セグメントから除外しました。

損益状況

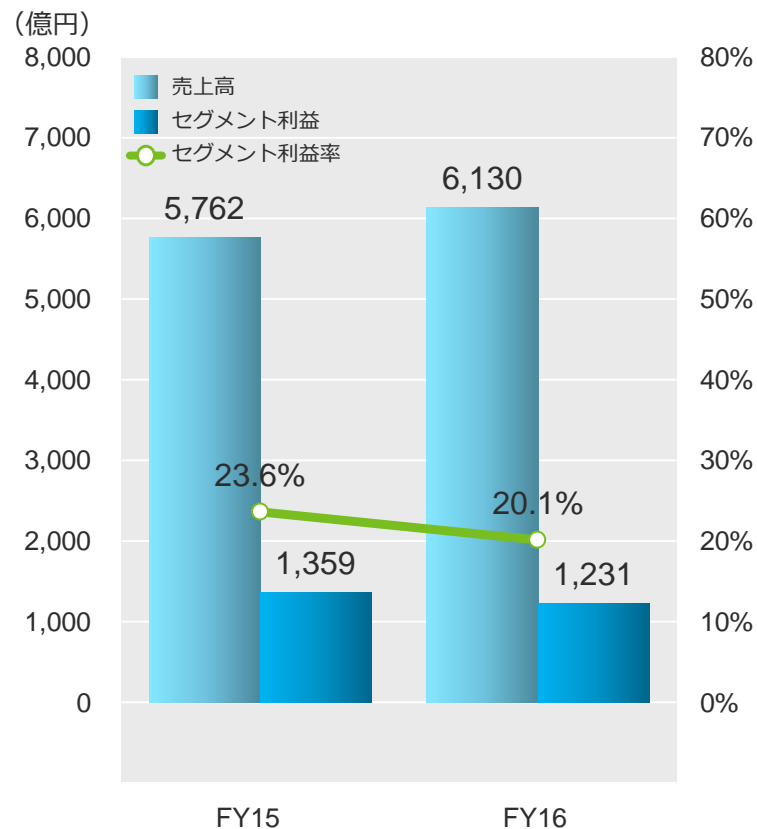
(億円)



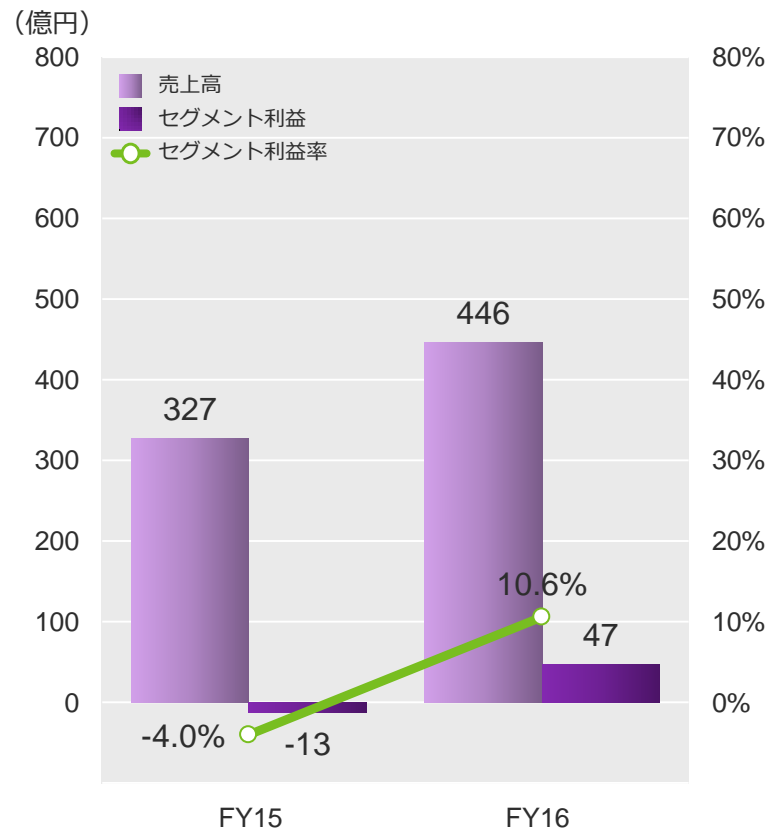
	FY12	FY13	FY14	FY15	FY16
売上高	6,330	4,972	6,121	6,131	6,639
営業利益	604	125	322	881	1,167
親会社株主に帰属する当期純利益	367	60	-194	718	778
売上総利益率	33.4%	31.9%	33.0%	39.6%	40.2%
営業利益率	9.5%	2.5%	5.3%	14.4%	17.6%

セグメント情報

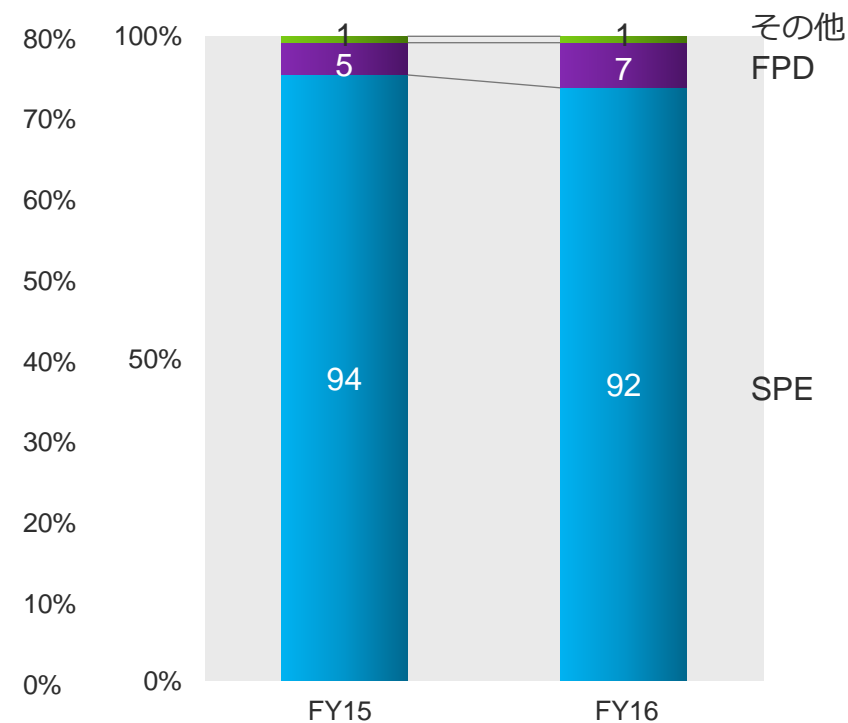
SPE (半導体製造装置)



FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)

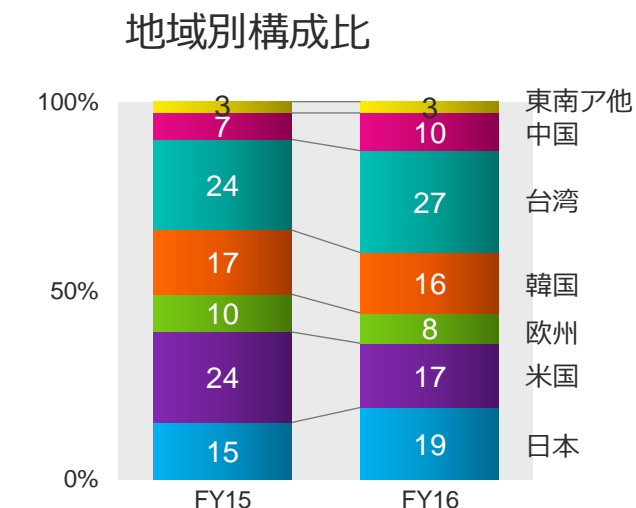
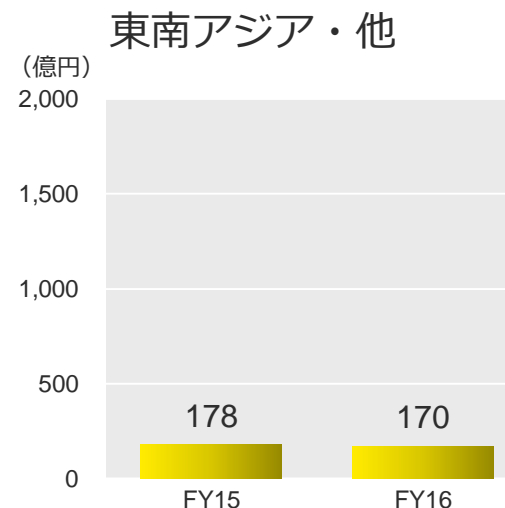
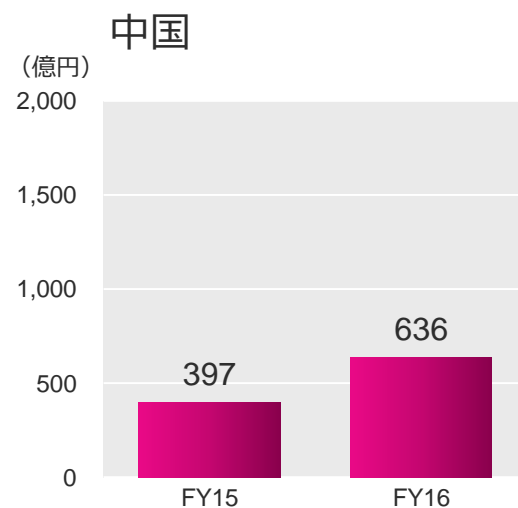
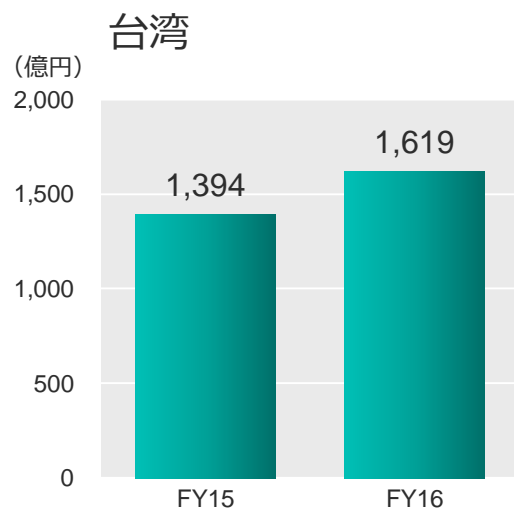
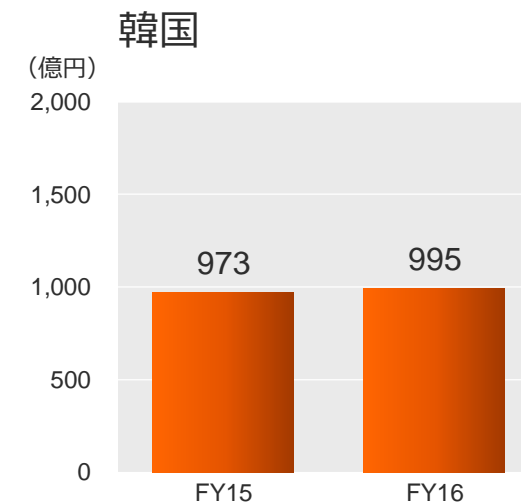
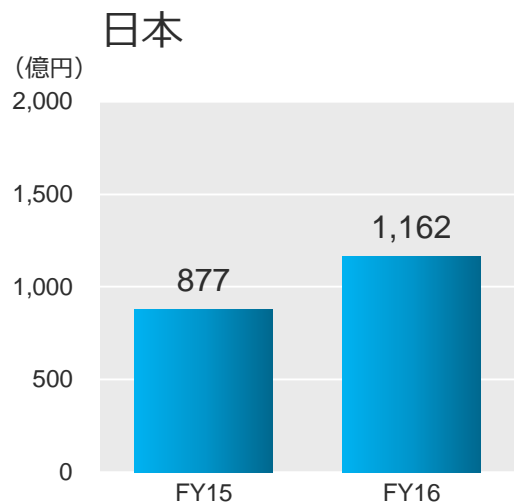


売上構成比率



1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

SPE部門地域別売上高



四半期 受注額・受注残高

2016/1-3月期

SPE	1,878億円 (+18%)
FPD	122億円 (-12%)
合計	2,000億円 (+15%)

(億円)

3,000

■ 半導体製造装置(SPE) ■ FPD製造装置

2,500

2,000

1,500

1,000

500

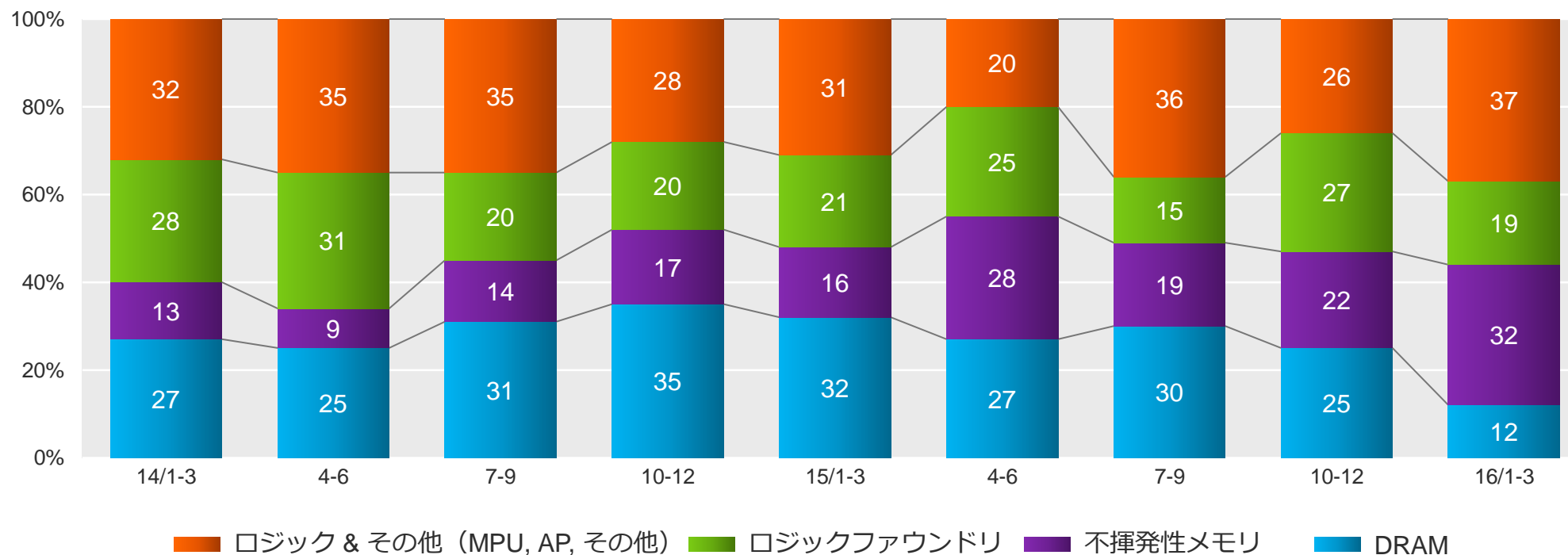
0

()内%は2015/10-12月期からの増減
増減率は1円単位の数字を元に計算

	14/1-3	4-6	7-9	10-12	15/1-3	4-6	7-9	10-12	16/1-3
SPE受注額	1,544	1,372	1,424	1,672	1,797	1,566	1,224	1,593	1,878
FPD受注額	166	142	48	34	126	118	125	139	122
SPE受注残高	2,099	2,110	2,170	2,523	2,604	2,767	2,226	2,354	2,737
FPD受注残高	290	293	291	288	316	333	376	399	374

ロジックと不揮発性メモリ向け受注が牽引、SPE受注は前四半期比18%増加

SPE受注アプリケーション別構成比

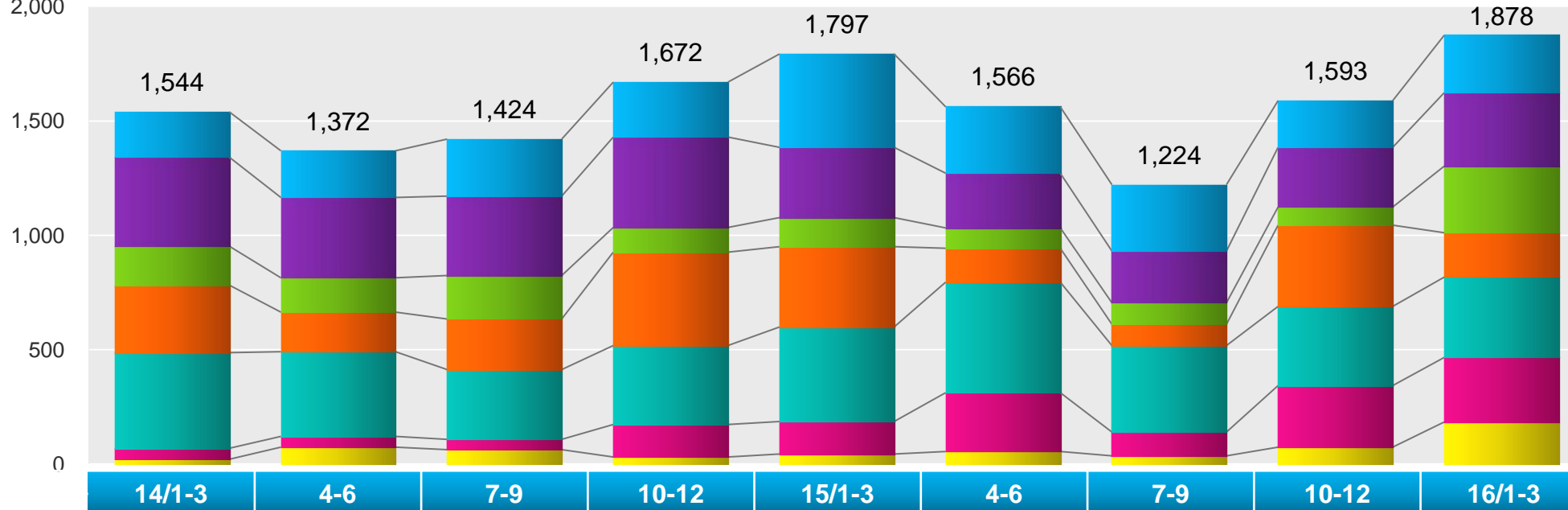


ロジックと不揮発性メモリ向けの構成比率が増加

グラフは装置本体受注額における構成比を示しています。

地域別SPE受注額

(億円)
2,000



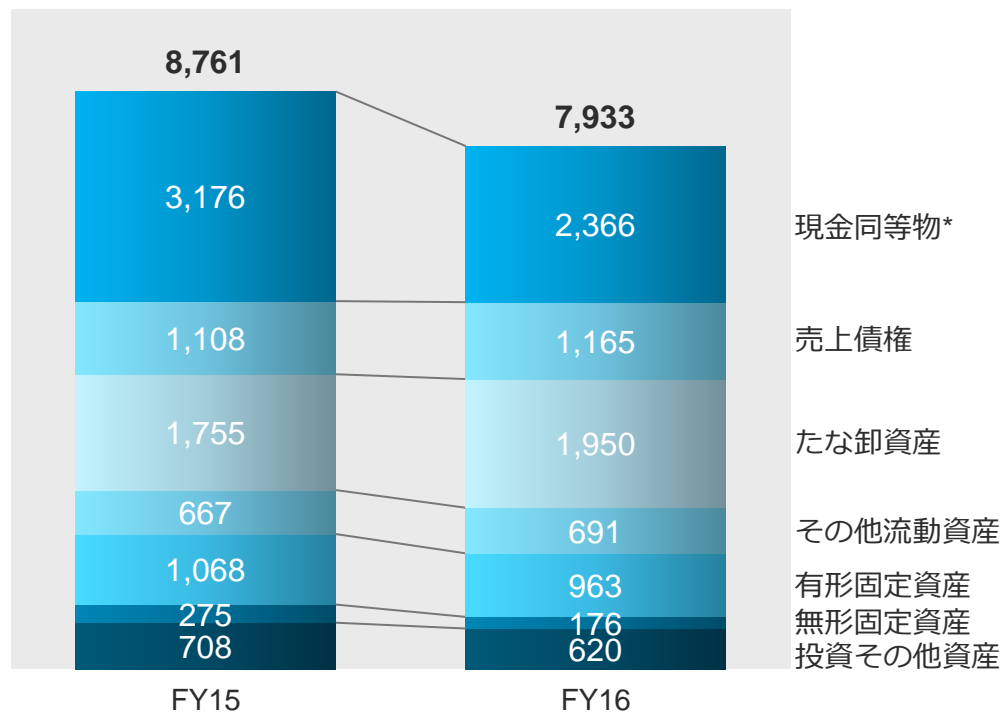
	14/1-3	4-6	7-9	10-12	15/1-3	4-6	7-9	10-12	16/1-3
国内	198	204	249	240	408	290	290	204	251
米国	389	351	347	395	307	239	226	261	321
欧州	170	150	190	108	127	89	94	79	291
韓国	295	173	221	408	351	148	93	355	194
台湾	418	370	305	345	413	483	378	346	351
中国	48	47	45	142	142	257	104	269	282
東南アジア・他	22	75	64	32	45	56	37	75	185

欧州のロジックと東南アジアの不揮発性メモリ向けが増加

貸借対照表

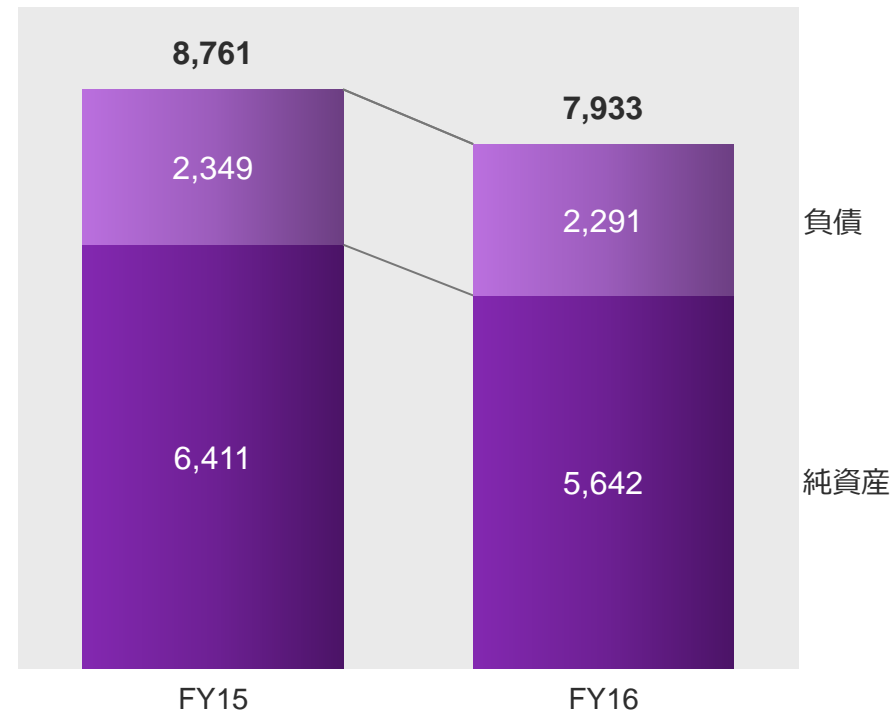
資産

(億円)



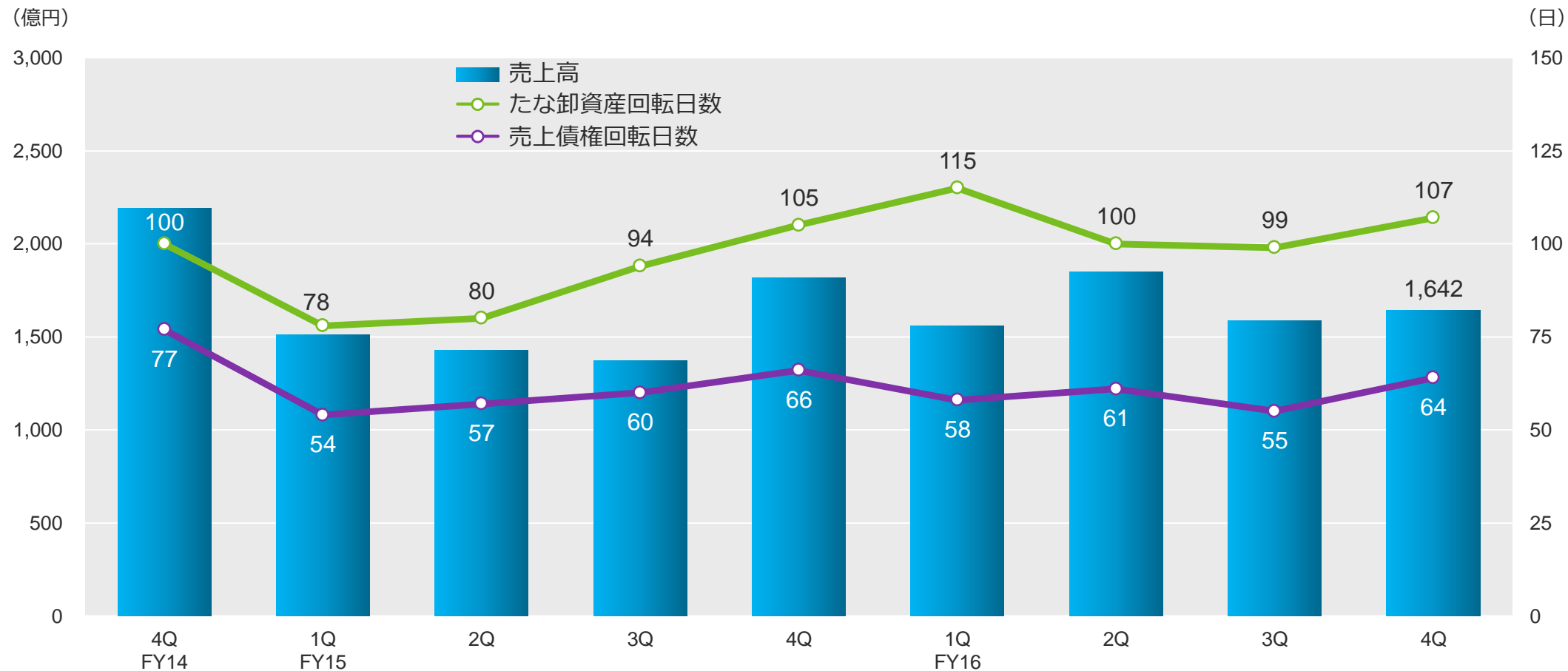
負債・純資産

(億円)



*現金同等物：現預金＋短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

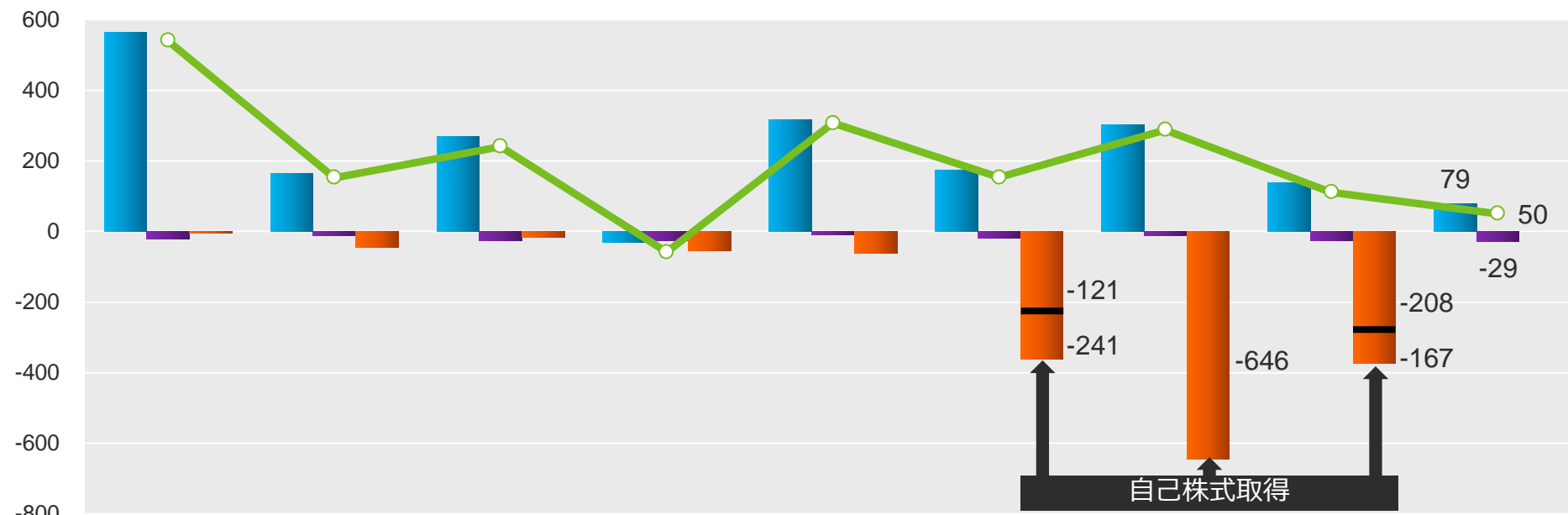
たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー

(億円)



	4Q FY14	1Q FY15	2Q	3Q	4Q	1Q FY16	2Q	3Q	4Q
営業キャッシュ・フロー	565	164	268	-32	317	173	301	138	79
投資キャッシュ・フロー*	-23	-12	-27	-26	-9	-20	-12	-27	-29
財務キャッシュ・フロー	-4	-46	-18	-54	-62	-363	-646	-375	0
フリーキャッシュフロー**	541	152	241	-59	307	153	288	111	50
手元資金残高***	2,681	2,800	2,991	2,853	3,176	2,989	2,607	2,338	2,366

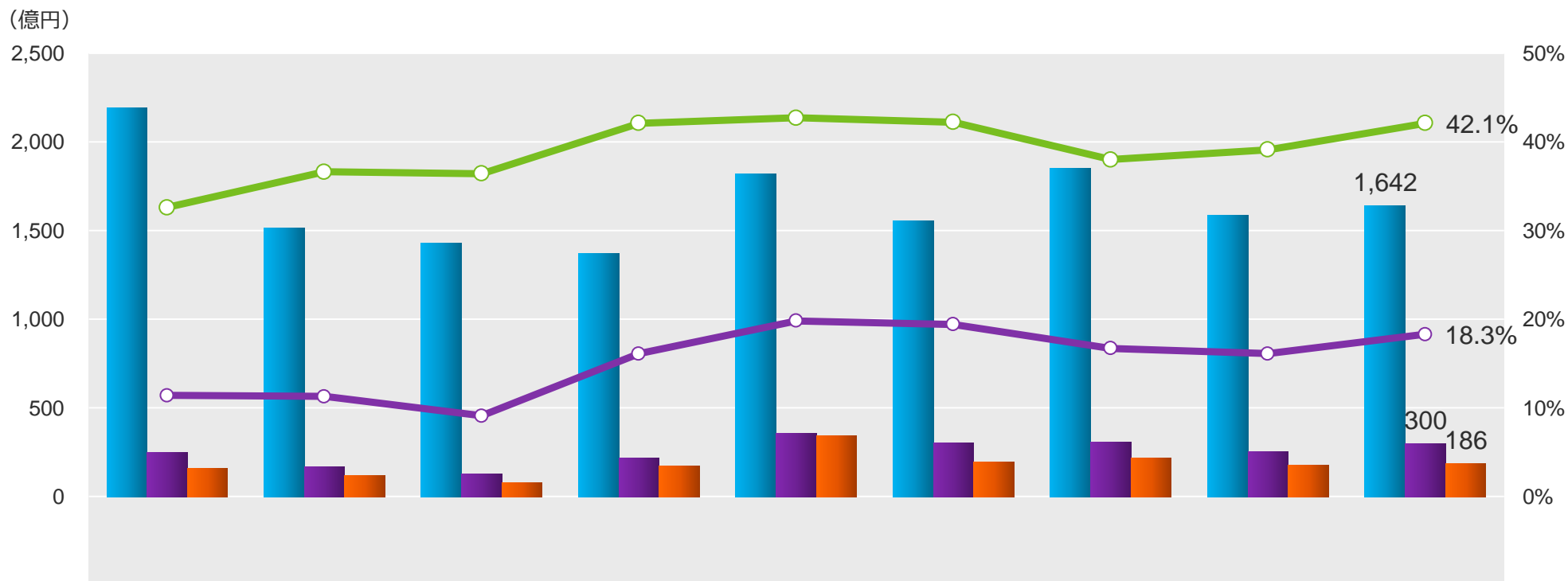
*投資キャッシュフローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

**フリーキャッシュフロー = 営業活動によるキャッシュフロー + 投資活動によるキャッシュフロー (満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く)

***手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

補足資料

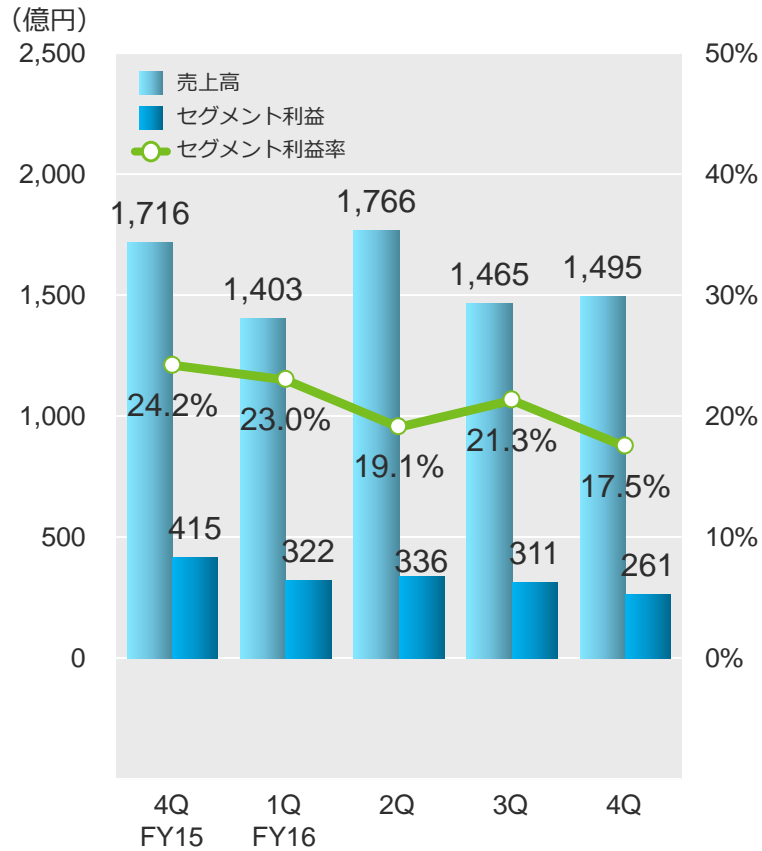
損益状況



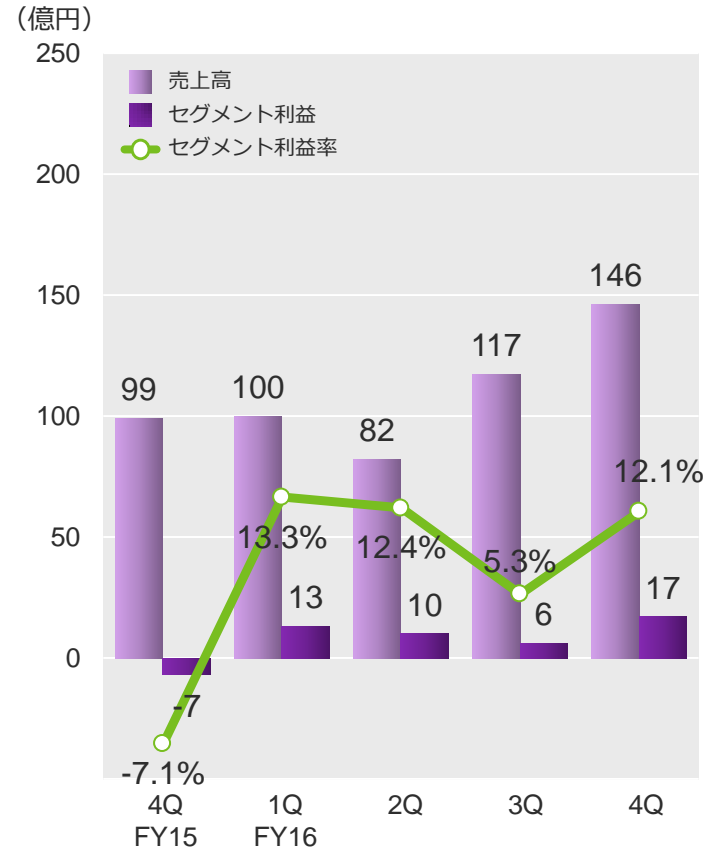
	4Q FY14	1Q FY15	2Q	3Q	4Q	1Q FY16	2Q	3Q	4Q
■ 売上高	2,192	1,513	1,429	1,370	1,818	1,557	1,851	1,587	1,642
■ 営業利益	249	170	130	220	359	302	309	255	300
■ 親会社株主に帰属する 当期純利益	162	118	81	174	344	194	218	178	186
● 売上総利益率	32.6%	36.6%	36.4%	42.1%	42.7%	42.2%	38.0%	39.1%	42.1%
● 営業利益率	11.4%	11.3%	9.1%	16.1%	19.8%	19.4%	16.7%	16.1%	18.3%

セグメント情報

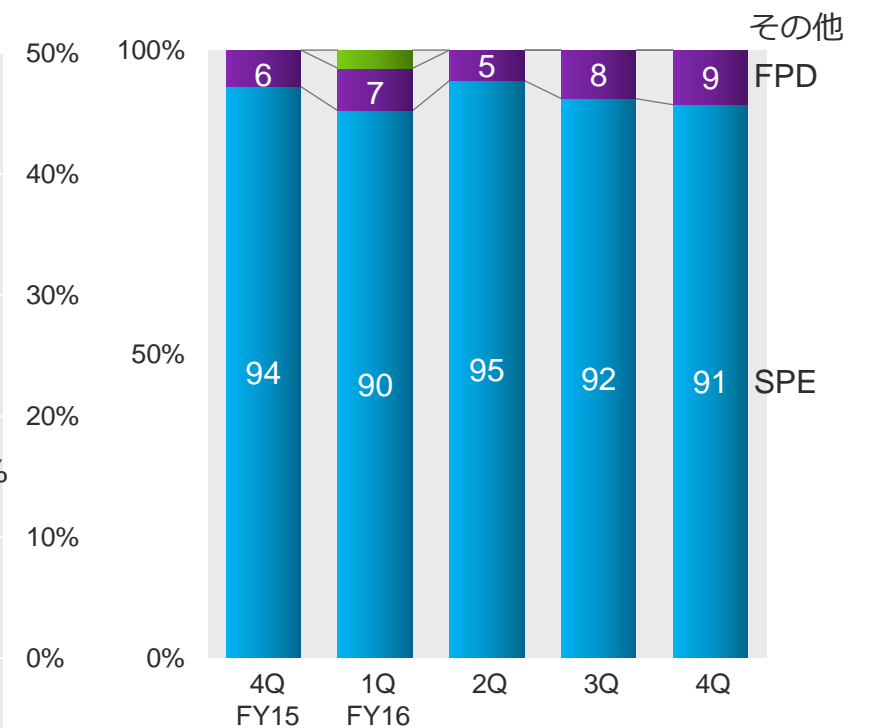
SPE (半導体製造装置)



FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)

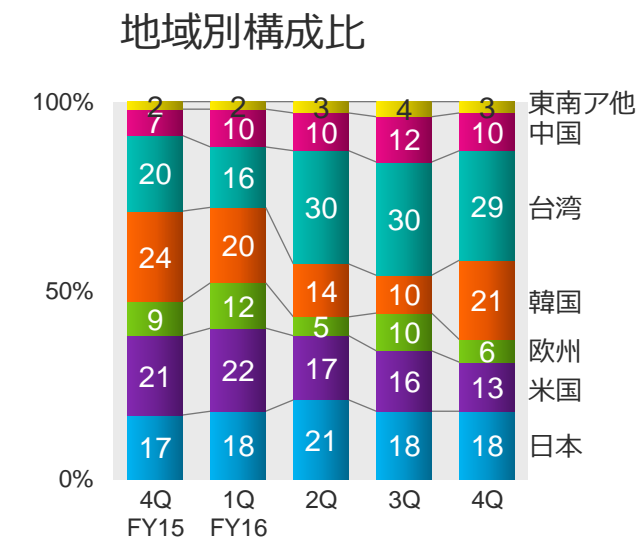
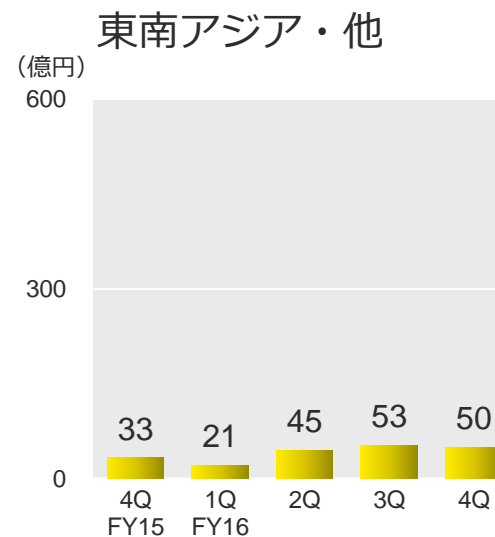
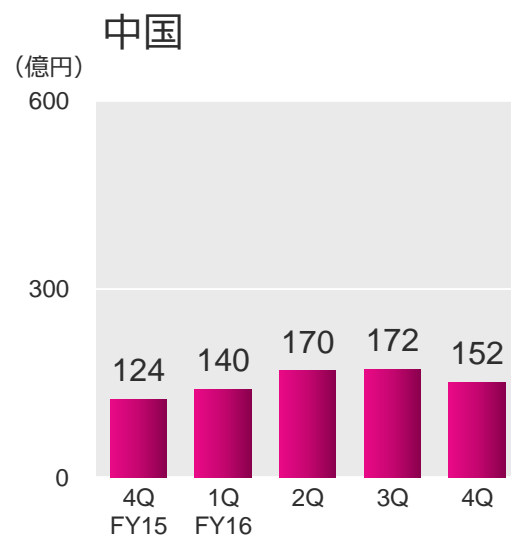
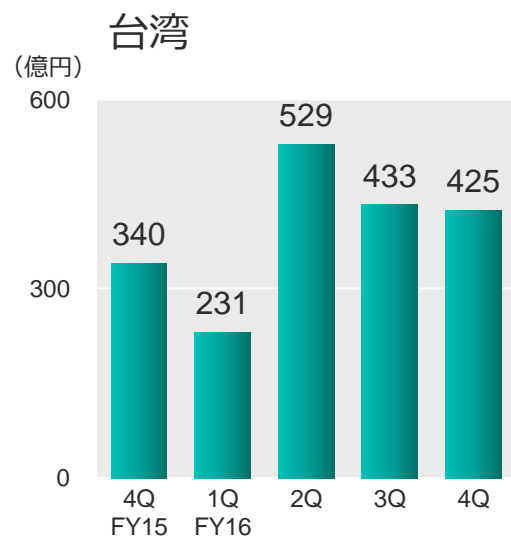
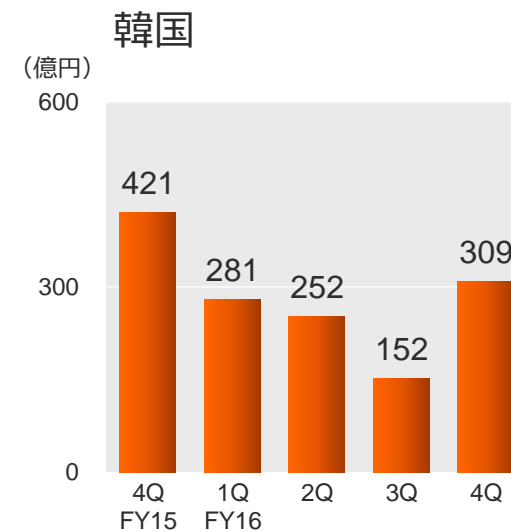
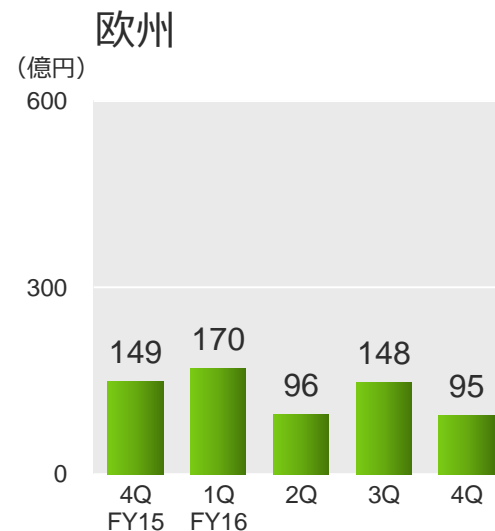
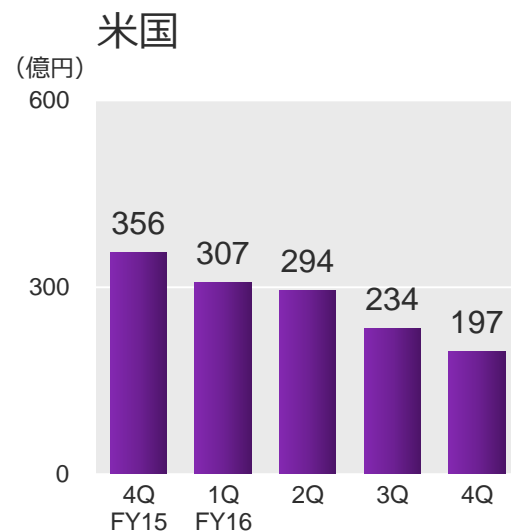
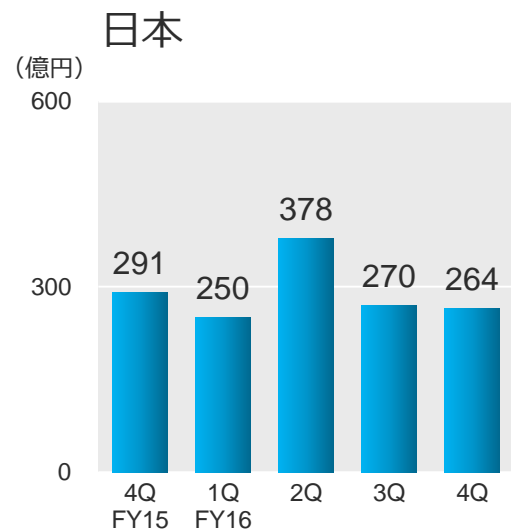


売上構成比率



1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

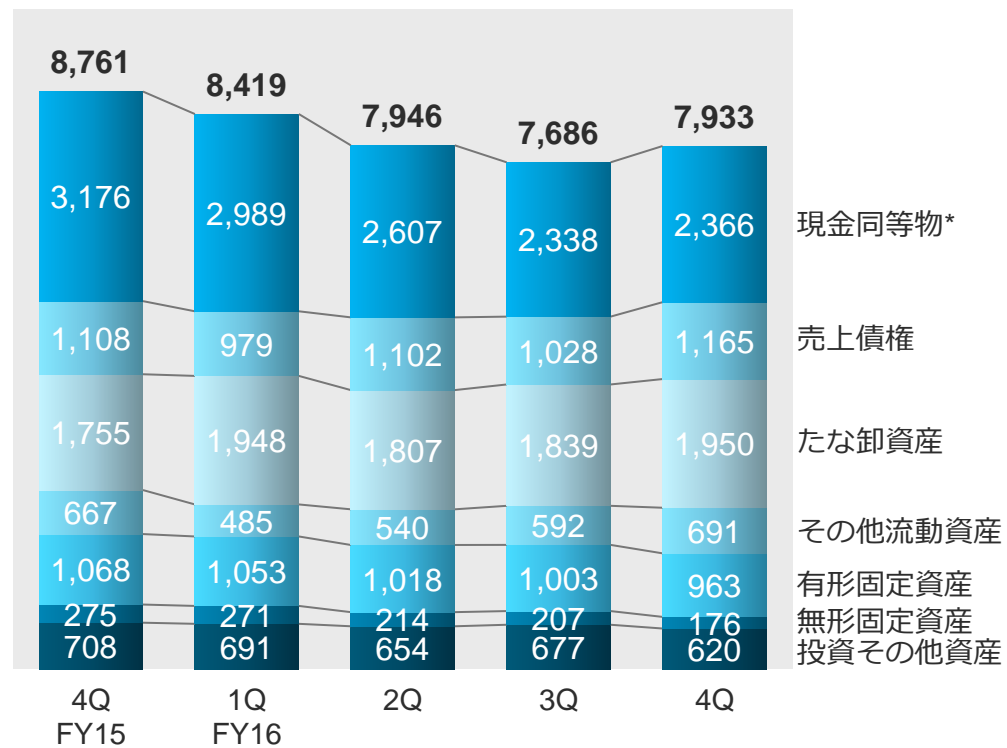
SPE部門地域別売上高



貸借対照表

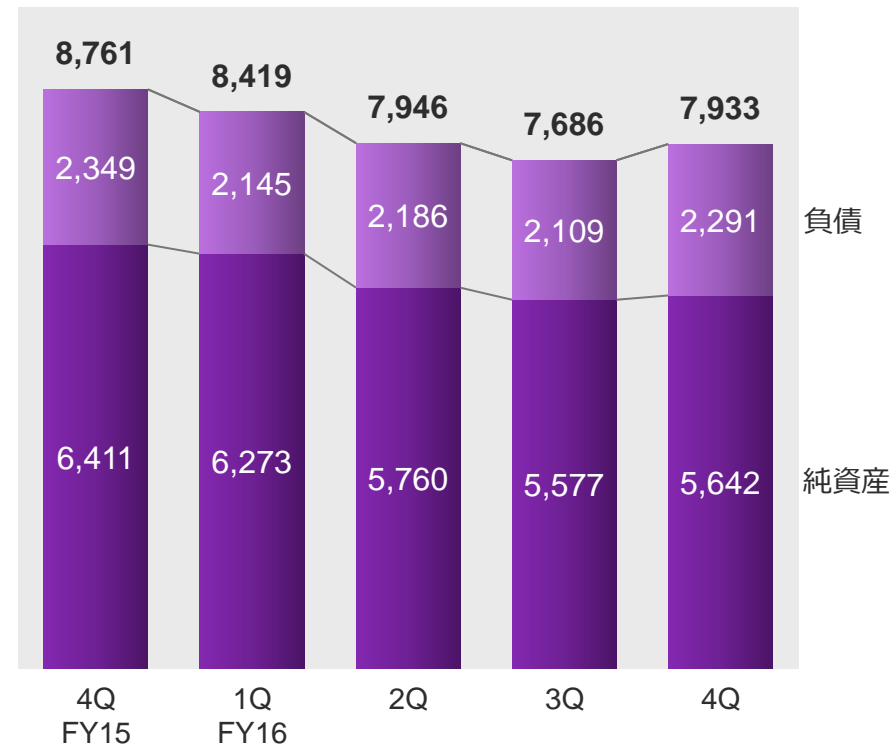
資産

(億円)



負債・純資産

(億円)



*現金同等物：現預金＋短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

従業員数

(人)

		2015年3月末	2016年3月末
	国内	7,166	7,060
	米国	1,622	1,586
	欧州	644	435
	アジア	1,412	1,548
合計		10,844	10,629

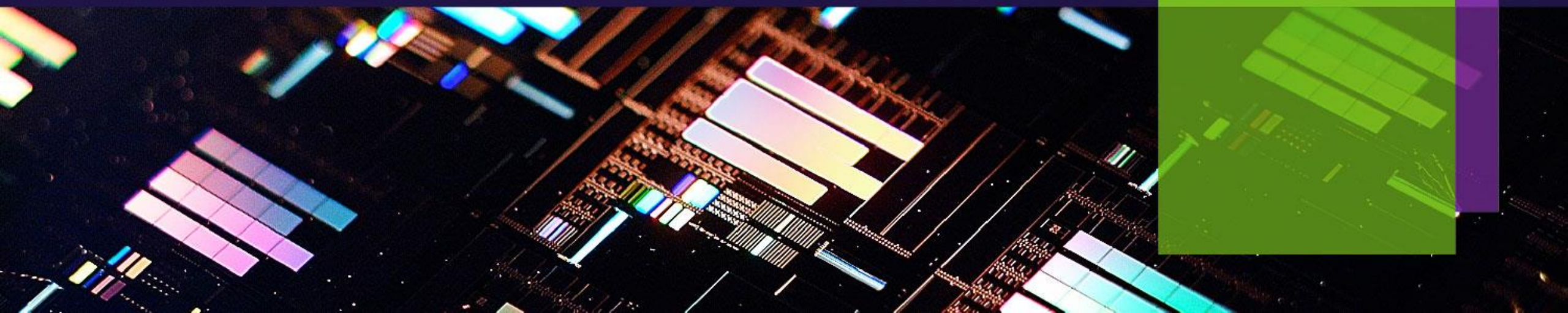


事業環境と新生TELを推進するアクション

2016年4月26日

河合 利樹

代表取締役社長、CEO



2016年3月期 事業ハイライト

- 2008年の世界金融危機以来、1,000億円超の営業利益を達成
- 前期比+8.3%の増収、売上総利益率40.2%、営業利益率17.6%を達成
- 2020年3月期に向けた中期経営計画を公表、新体制始動
- 新株主還元策を公表、1,540万株*の自己株式の消却、過去最高の配当を予定
- 中期計画に向けたSPEの注力分野でPOR**取得（技術認定）が着実に進展
- 中期計画との連動性を重視した攻めのガバナンスを構築、発表

* 消却前の発行済株式の総数に対する割合8.53%

** POR (Process of Record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

2016年3月期 SPE事業サマリー

市場シェア	CY2014	CY2015
エッチング装置	26%	19%
熱処理成膜装置	55%	54%
枚葉成膜装置	5%	6%
洗浄装置	25%	24%
売上高	FY2015	FY2016
フルソリューション事業	>1,700億円	>1,850億円



CY2019目標
>36%
>65%
>10%
>35%
FY2020目標
>2,000億円

- 注力分野においてPOR取得に進展、中期計画の目標達成に変更なし

エッチング装置

先端パターンニング一括エッチング、3D-NAND HARC工程*拡大

ALD装置

バッチ、セミバッチ装置とともにALD**のポジション向上

洗浄装置

ロジック・メモリーとともに注力工程採用、ドライ洗浄の工程拡大

* HARC (High Aspect Ratio Contact) 工程：高度な加工技術を要する深穴形成工程

** ALD (Atomic Layer Deposition)：原子レベルで一層ずつ膜を堆積させる成膜手法

2017年3月期 SPE事業の重点課題

コータデベロッパ

先端液浸・EUVにおいて、シェア85%以上を維持

エッチング装置

3D-NANDの採用工程拡大、新製品でパターニング工程拡大

熱処理成膜装置

ALD製品のポジション向上、セミバッチALD装置のPOR拡大

枚葉成膜装置

新製品によるSAM*拡大、STT-MRAM**の量産プロセス確立

洗浄装置

3D-NAND向けバッチ装置の拡販、枚葉・ドライ装置の製品強化

テストシステム

3D-NAND向けにCellcia™を展開

* SAM (Served Available Market) : 製品対象市場

** STT-MRAM (Spin Transfer Torque-Magneto-resistive Random Access Memory) : 低消費電力が期待できる磁気メモリ

新生TELを推進するアクション

開発組織の一元化 強いNext Generation Productの創出

- 注力分野へ開発リソースを最適配置
- TELの持つ多様な技術（ウエット/ドライ/常圧/減圧/プラズマ/熱制御）を融合し、次世代・次々世代装置のソリューションを提案
- コンソーシア、材料メーカーとの戦略的協業
- IoT*/AI**時代を見据えた半導体技術の多世代、多様化への対応

* IoT (Internet of Things) : モノのインターネット

** AI (Artificial Intelligence) : 人工知能

新生TELを推進するアクション

アカウント新体制導入

背景

- 顧客の要望の変化
単一装置の性能からデバイスの製造手法・工程の最適化へ
- 海外売上比率80%、半導体メーカーの再編

アクション

- 顧客毎に営業・開発責任者を任命
- 顧客ニーズ創造型の技術マーケティングを追求

目的

- 高付加価値製品によるトップシェアの実現と収益力向上

事業環境

▶ 半導体設備投資

CY2016の半導体前工程（WFE*）の設備投資額は、前年同水準を見込む

- メモリ：DRAM向け投資は一巡、3D-NAND向け投資が拡大
- ファウンドリ／ロジック：年後半から先端ノード向け投資が立ち上がる

▶ FPD設備投資

CY2016のTFTアレイ工程**向けのFPD製造装置の需要は、モバイル用途の中小型パネル向け設備投資を中心に、前年比20%の増加を見込む

(2016年4月時点での見方)

**不安定なマクロ経済の環境の中、
装置市場は技術革新の波に乗り、堅調な推移を想定**

* WFE (Wafer Fab Equipment)：半導体製造工程には、ウェハー状態で回路形成・検査をする前工程と、チップごとに切断・組立・検査をする後工程があります。
WFEは、前工程で使用される製造装置です。

** TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動させる側の基板を製造する工程

FPD事業戦略

■ 前期の成果

- 前期比37%の売上増加、セグメント利益率10.6%に向上
- 第10.5世代基板サイズ対応装置の受注開始
エッチング装置 Impressio™ 3300、コータ/デベロッパ Exceliner™ 3300

■ 今期の重点課題

- モバイル向け市場において新製品PICP™*エッチング装置によるシェア拡大
- インクジェット描画装置による有機ELパネル量産プロセスの確立

*PICP (Planer Inductively Coupled Plasma) : パネル基板上に極めて均一な高密度プラズマを生成するプラズマソース

2017年3月期 業績・配当予想について

- 熊本地震の影響と対応
 - 建屋および生産設備への大きな影響はない
 - 生産に関しては、現段階で4週間程度の遅延影響
但し、休日対応を含めた特別生産シフトで遅れを取り戻す計画
並行して、顧客納入先での据付期間の短縮を図る
全体としては、6月末までに通常の生産体制に戻せる見込み
- 2017年3月期の業績予想については、市場成長以上の増収を見込むが、地震の影響をより精査するため、5月12日に公表する予定

**革新的な技術力と、
多様なテクノロジーを融合する独創的な提案力で、
半導体産業とFPD産業に高い付加価値と利益を生み出す
真のグローバルカンパニーへ**

TEL TM

TOKYO ELECTRON

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV：フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル

TEL™

TOKYO ELECTRON